

Тип микросхемы	$U_{\text{ВЫХ}}^0$ В, <=	$U_{\text{ВЫХ}}^1$ В, >=	$I_{\text{ВХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВХ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}$ мА, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{1.0}$ нс, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{0.1}$ нс, <=	$P_{\text{ПОТ}}$ мВт	$P_{\text{ПОТ.СР.}}$ мВт	$I_{\text{ПОТ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}^0$ мА, <=	Примечание
133ЛН2	0.4	2.4	-1.6	0.04		15	22			12	33	
К155ЛН2	0.4	2.4	-1.6	0.04		15	22			12	33	
530ЛН2 М530ЛН2 Н530ЛН2 К531ЛН2П	0.5		-2	0.05		7	7.5			19.8	54	
533ЛН2	0.4	2.5	-0.4	0.02		28	32			2.4	6.6	Краз = 10
555ЛН2	0.5	2.7	-0.4	0.02		28	32		23.4	2.4	6.6	$U_{\text{ВЫХ}}^1 = 2.7\text{В}$ при $I_{\text{ВЫХ}}^1 = 100\text{мкА}$
К555ЛН2 КМ555ЛН2	0.5	2.7	-0.36	0.02		28	32			2.4	6.6	
1533ЛН2	0.4	2.5	-0.2	0.02		29	59			1.1	3.8	
133ЛН3	0.4	2.4	-1.6	0.04		2.3	15			48	51	